PCT

(30) 優先権データ

特願平10/294946

特顧平11/153292

世界知的所有權機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 H01C 7/02		A1	(11) 国際公開番号	WO00/24010
			(43) 国際公開日	2000年4月27日(27.04.00)
(21) 国際出願番号			6 池田隆志(IKEDA, Takas) 〒544-0004 大阪府大阪	uì)[JP/JP] 市生野区巽北2-8-17 Osaka, (JP)
(22) 国際出願日	1999年10月15日(1	5.10.9)) (74) 代理人	, <u> </u>

1999年6月1日(01.06.99) (71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 松下電器産業株式会社

1998年10月16日(16.10.98)

(MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]

〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

岩尾敏之(IWAO, Toshiyuki)[JP/JP]

〒573-0071 大阪府枚方市茄子作1丁目9-5-201 Osaka, (JP) 森本光一(MORIMOTO, Koichi)[JP/JP]

〒591-8021 大阪府堺市新金岡町2-5-6-203 Osaka, (JP)

池内揮好(IKEUCHI, Kiyoshi)[JP/JP]

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-14-3-204 Hyogo, (JP)

小島潤二(KOJIMA, Junji)[JP/JP]

〒573-0165 大阪府校方市山田池東町46-4-403 Osaka, (JP)

岩橋文雄, 外(IWAHASHI, Fumio et al.) 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 Osaka, (JP)

(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: PTC CHIP THERMISTOR

(54)発明の名称 チップ形PTCサーミスタ

A PTC chip thermistor comprises a conductive PTC polymer body; first and second outer electrodes; one or more inner electrodes disposed in the polymer body; and first and second side electrodes being in direct electrical connection with the first outer electrode. The odd and even inner electrodes are connected directly with the second side electrode and the first side electrode, respectively. A relation, a/L, is determined to range from 3 to 6, where a is the distance from the odd inner electrode to the first electrode or from the even inner electrode to the second electrode, and t is the distance between adjacent inner electrodes or the distance from the first and second outer electrodes to the adjacent inner electrode.

(57)要約

本発明のチップ型PTCサーミスタはPTC特性を有する導電性ポリマと、第1,第2の外層電極と、導電性ポリマに挟まれた1以上の内層電極と、第1の外層電極と直接電気的に接続する第1、第2の外層電極に直接接続し、第2の外層電極は第1の電極に直接接続し、第2の外層電極は第1の電極に直接接続し、第2の外層電極は第2の個面電極と高数番目の内層電極が全部で奇数個の場合に第1の側面電極と低数番目の内層電極から第2の電極までの間隔または偶数番目の内層電極から第2の電極までの間隔を10間隔または第1,第2の外層電極から隣り合う内層電極までの間隔を1としたとき、a/tを3~6とする。

ζ.

D scription

明細書

10

チップ形PTCサーミスタ

5 技術分野

15

本発明は、正の温度係数 (Positive Temperature Coefficient、以下「PTC」と記す) 特性を有する導電性ポリマを用いたチップ形PTCサーミスタ、特に積層型のチップ形PTCサーミスタに関するものである。

20

10 背景技術

25

導電性ポリマを用いたPTCサーミスタは過電流保護素子として使用されている。過電流保護素子は電気回路に過電流が流れると、PTC特性を有する導電性ポリマが自己発熱し、導電性ポリマが熱膨張して高抵抗に変化し、回路の電流を安全な微小領域まで減衰させるものである。

15 以下、従来のチップ形PTCサーミスタ (以下PTCサーミスタ) について説明する。

30

従来のPTCサーミスタとしては、特開平9-69416号公報に示されているように、導電性ポリマ層と導体からなる内部電極とを、内部電極間に介在する 導電性ポリマ層の層数が2層以上となるように交互に積層してPTCサーミスタ

35

20 素体を構成し、このPTCサーミスタ素体の側面に、それぞれ対向する内部電極 に接続される外部電極を設けたチップ形PTCサーミスタが開示されている。

40

第20図は従来のチップ形PTCサーミスタの断面図である。第20図において、導電性ポリマ1はポリエチレン等の高分子材料にカーボンブラック等の導電性粒子が混在されたシートを架橋したものである。導体からなる内部電極2a、

45

25 2 b、2 c、2 dは、シート状の導電性ポリマ 1 と積層してPTCサーミスタ素体3を構成している。PTCサーミスタ素体3の側面にはそれぞれ対向する内部電極2 a、2 b、2 c、2 dに接続された外部電極4 a、4 bがある。

上記した従来のPTCサーミスタは、小型化および大電流化を図ろうとした場合、下記のような問題点を有していた。

2

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PTCサーミスタにおいて小型・大電流化を図るためには、PTCサーミスタの直流抵抗を低抵抗化する必要がある。導電性ポリマ1の比抵抗値を低くするためには、導電性ポリマ中の導電性粒子の充填量を多くすることが有効である。しかし、PTCサーミスタの場合は直流抵抗は低抵抗化できるが、同時に、重要な PTC特性である抵抗値上昇率が低下して異常時の電流を遮断しにくくなるという問題点を有していた。

また、内部電極2a、2b、2c、2d間の導電性ポリマ1.の厚みを薄くする ことによって低抵抗化できるが、この場合も、上記と同様に抵抗値上昇率の低下・ 耐電圧の低下という問題点を有していた。

10 そしてまた、内部電極2a、2b、2c、2dの対向面積を大きくすることによって低抵抗化でき、かつ積層構造としてその積層数を増やすことによって対向面積を大きくすることができる。しかし、積層数を増やした場合、積層体の総厚が厚くなるとともに、導電性ポリマIの膨張によって生じる応力による内部電極2a、2b、2c、2dと外部電極4a、4bの接続部の信頼性劣化等の問題点があり、積層数の増加にも限界がある。

従って、低抵抗化のためには、内部電極2a、2b、2c、2dと外部電極4a、4b間の距離を短くして1層あたりの対向面積を大きくする必要がある。ところが、外部電極4a、4b付近の導電性ポリマ1は内部電極2a、2b、2c、2dに接続されていて膨張しにくい構造である。このため、過電流によって導電20 性ポリマ1が膨張した際に、外部電極4a、4b付近の導電性ポリマ1の膨張は小さく、その近辺の比抵抗値は他の部分と比較して低いままである。そのため、内部電極2a、2b、2c、2dと外部電極4a、4b間の距離が短い場合は、PTCサーミスタとしての抵抗値上昇率は低くなってしまう。従って、PTCサーミスタにおいて、積層構造として対向面積を大きくすることにより低抵抗化を図ると、抵抗値上昇率が低くなる可能性があるという問題点を有していた。

本発明は上記従来の問題点を解決するもので、小型で大電流用途に対応できかつ十分な抵抗値上昇率が得られるチップ形PTCサーミスタを提供することを目的とするものである。

発明の開示

3

本発明のPTCサーミスタは、PTC特性を有する導電性ポリマと、 前記導電性ポリマに接触して設けられた第1の外層電極と、 前記導電性ポリマを介し前記第1の外層電極に対向して設けられた第2の。

前記導電性ポリマを介し前記第1の外層電極に対向して設けられた第2の外層電極と、

5 前記第1の外層電極および前記第2の外層電極とに対向すると共にこれらの間に 位置しかつ前記導電性ポリマに挟まれた1以上の内層電極と、

前記第1の外層電極と直接電気的に接続する第1の電極と、

前記第1の電極と電気的に独立して設けられた第2の電極とを有し、

前記1以上の内層電極のうち前記第1の外層電極に最も近い位置に設けられた内 10 層電極を1番目とし、順番に数えてn番目に位置する内層電極をn番目の内層電 極としたとき、

奇数番目の内層電極は前記第2の電極に直接接続し、

偶数番目の内層電極は前記第1の電極に直接接続し、

前記内層電極が全部で奇数個の場合には前記第2の<u>外層</u>電極と前記第1の電極が 直接電気的に接続し、前記内層電極が全部で偶数個の場合には前記第2の<u>外層</u>電 極と前記第2の電極が直接電気的に接続する構成であり、

前記奇数番目の内層電極から前記第1の電極までの間隔または前記偶数番目の内 層電極から前記第2の電極までの間隔をaとし、

前記内層電極のうち隣り合う内層電極の間隔または前記第1の外層電極若しくは 20 前記第2の<u>外層</u>電極と隣り合う内層電極から前記第1の<u>外層</u>電極若しくは前記第 2の外層電極までの間隔をtとしたとき、

a/tが3~6であることを特徴とする。

この構成によれば、PCTサーミスタの抵抗値を低く押さえることができ、かつ十分な抵抗値上昇率が得られるものである。このため、本発明のPCTサーミスタは小型で大電流用途に対応でき、かつ十分な過電流阻止能力が得られるものである。なお、ここで述べる抵抗値上昇率とは、過電流が流れた時のPCTサーミスタの抵抗値を通常の電流が流れた時の抵抗値で除した値を言う。本発明はa/tを3~6とすることで上記作用を得るものである。

図面の簡単な説明

55

50

15

25

20

30

35

40

15

20

25

30

35

40

45

50

(実施例1)

以下、本発明の実施例1におけるPTCサーミスタについて図面を参照しなが 25 ら説明する。

第1図(a)は本発明の実施例1におけるPTCサーミスタの斜視図、第1図(b)は第1図(a)のA-A線断面図である。

第1図(a)、(b) において、導電性ポリマ11は結晶性ポリマの一つである 高密度ポリエチレンと導電性粒子であるカーボンブラック等との混合物からなり、

55

4

第1図(a)は本発明の実施例1におけるPTCサーミスタの斜視図、第1図 (b)は第1図(a)におけるAーA線断面図、第2図(a)~(c)は本発明 の実施例1におけるPTCサーミスタの製造方法を示す工程図、第3図(a)~ (e)は本発明の実施例1におけるPTCサーミスタの製造方法を示す工程図、

第4図(a)は実施例1における抵抗と温度特性の一例を示す特性図、第4図(b)は実施例1における125℃における測定結果を示す図、第5図は実施例1におけるPTCサーミスタの断面図、第6図(a)、(b)は実施例1における他のPTCサーミスタの断面図、第7図は実施例1におけるさらに他のPTCサーミスタの断面図、第8図は実施例2におけるPTCサーミスタの断面図、第9図(a)

10 ~ (c) は実施例2におけるPTCサーミスタの製造方法を示す工程図、第10図(a)~(c) は実施例2におけるPTCサーミスタの製造方法を示す工程図、第11図は実施例2におけるPTCサーミスタの断面図、第12図(a)、(b) は実施例2におけるPTCサーミスタの断面図、第13図は実施例2における他のPTCサーミスタの断面図、第14図は実施例3におけるPTCサーミスタの

15 断面図、第15図(a)~(c)実施例3におけるPTCサーミスタの製造方法を示す工程図、第16図(a)~(c)は実施例3におけるPTCサーミスタの製造方法を示す工程図、第17図は実施例3におけるPTCサーミスタの断面図、第18図(a)、(b)は実施例3におけるPTCサーミスタの断面図、第19図は実施例3における他のPTCサーミスタの断面図、第20図は従来のPTCサーミスタの断面図である。

発明の実施するための最良の形態

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PTC特性を有する。第1の外層電極12aは導電性ポリマ11の第1面に位置し、第2の外層電極12bは導電性ポリマ11の第1面に対向する第2面に位置する。第1、第2の外層電極はそれぞれ鋼あるいはニッケル等の金属箔からなる。ニッケルめっき層からなる第1の電極13aは導電性ポリマ11の一方の側面全面および第1の外層電極12aと第2の外層電極12bの端線部とに回り込むように設けられ、かつ第1の外層電極12aと第2の外層電極12bとを電気的に接続する。ニッケルめっき層からなる第2の電極13bは電極13aに対向する他方の側面全面および前記導電性ポリマ11の第1面と第2面とに回り込むように設けられている。第1、第2の保護コート14a、14bは導電性ポリマ11の第1面と第2面の最外層に設けられ、エポキシ変性アクリル系樹脂からなる。鋼あるいはニッケル等の金属箔からなる内層電極15は導電性ポリマ11の内部に位置して外層電極12aと外層電極12bに平行に設けられ、かつ側面電極13bと電気的に接続されている。

以上のように構成された実施例1におけるPTCサーミスタについて、次にそ 0製造方法を図面を参照しながら説明する。

第2図 (a) ~ (c) および第3図 (a) ~ (e) は、実施例 1 における PT Cサーミスタの製造方法を示す工程図である。

まず、結晶化度70~90%の高密度ポリエチレン42重量%と、ファーネス 法で製造した平均粒径58nm、比表面積38m²/gのカーボンブラック57 20 重量%と、酸化防止剤1重量%とを約170℃に加熱した2本熱ロールにより約 20分間混練し、そして前記混合物を2本熱ロールからシート状で取り出し、第 2図(a)に示す厚みが約0.16mmのシート状の導電性ポリマ21を作製した。

次に、約80μmの電解顕箔に金型プレスによりパターン形成を行い、第2図 (b)に示す電極22を作製した。第2図(b)の溝28は後工程で個片状に分割したときに、側面電極と外層電極あるいは内層電極とを一定の間隔をもって独立させるためのギャップを形成する。溝29は個片状に分割するときに、電解銅箔を切断する部分を減らし、分割時の電解銅箔のダレやバリを無くするために形成する。さらに溝29は、電解銅箔を切断することにより側面への電解銅箔の切

10

15

20

25

30

35

40

45

6

断面が露出し、電解鋼箔が酸化したり、実装時にはんだによるショートが起こる のを防ぐ。

なお、電極22はPTCサーミスタの完成時には、第1図の外層電極12a、 外層電極12bおよび内層電極15を形成するものである。

5 次に、第2図(c)に示すように、2枚のシート状の導電性ポリマ21と3枚の電極22を電極22が最外層にくるように交互に重ね、温度175℃、真空度約20Torr、面圧力約75kg/cm2で約1分間の真空熱プレスにより加熱加圧成形し、第3図(a)に示す一体化した第1のシート23を作製した。

その後、一体化した第1のシート23を熱処理(110℃~120℃で1時間) 10 した後、電子線照射装置内で電子線を約40Mrad照射し、高密度ポリエチレンの架橋を行った。

次に、第3図(b)に示すように、ダイシングにより、細長い一定間隔の貫通 溝24を所望のPTCサーミスタの長手方向の幅を残して形成した。

次に、第3図(c)に示すように、貫通構24を形成した第1のシート23の 上下面に貫通構24の周辺を除いて、エポキシ変性アクリル系のUV硬化と熱硬化との併用硬化型樹脂をスクリーン印刷した。続いて、UV硬化炉で上下面を片面ずつ仮硬化し、その後、熱硬化炉で両面同時に本硬化を行って保護コート25を形成した。保護コート25は完成時には第1の保護コート14aおよび第2の保護コート14bを形成するものである。

20 次に、第3図(d)に示すように第1のシート23の保護コート25が形成されていない部分と貫通溝24の内壁に約20μmのニッケルめっき層からなる側面電極26を形成した。ニッケルめっきはスルファミン酸ニッケル浴中で約40分間、電流密度約4A/dm²の条件で行った。

その後、第3図(d)に示すシート23をダイシングにより個片に分割し、第 25 3図(e)に示す本発明のPTCサーミスタ27を作製した。

次に、本発明においてPTCサーミスタの十分な抵抗値上昇率を得るために、 第1図における側面電極13aと内層電極15間の間隔aと、外層電極12aま たは外層電極12bと内層電極15間の導電性ポリマ11の厚みtとの比a/t の範囲を規定することの必要性について説明する。

10

15

20

10

25

30

35

40

45

50

既に説明したように、内層電極15と第1の側面電極13a間の間隔aが短い場合は、PTCサーミスタの抵抗値上昇率は低くなってしまうため、内層電極15と第1の側面電極13a間の間隔aは抵抗値上昇率が低くならないように規定する必要がある。一方、PTCサーミスタは常温での抵抗値を低くするために積 層構造としているため、外層電極12aまたは外層電極12bと内層電極15との対向面積が大きくなるようにするためには、内層電極15と側面電極13a間

7

本実施例1に記載した製造方法で、外層電極12aまたは外層電極12bと内層電極15間の導電性ポリマ11の厚みtを0.15mmに固定して、側面電極13aと内層電極15間の間隔aが0.15mm~1.2mmまで0.15mm問隔で変化するように電解鋼箔のパターン形成を行ってそれぞれのサンプルを作製した。

の間隔αを必要以上に長くすることはできない。

次いで、側面電極13aと内層電極15間との間隔aを変化させたことにより 抵抗値上昇率の違いを確認するために以下の試験を行った。

試験は間隔aが0.15mm~1.2mmまで0.15mm間隔で変化するように形成したサンプルをそれぞれ5個ずつブリント基板に実装し、恒温槽の中に置いた。恒温槽の温度25℃から150℃まで2℃/分で上昇させ各温度でサンプルの抵抗値を測定した。第4図(a)に間隔aが0.15mmと0.9mmのときの抵抗/温度特性の一例を示す。また、第4図(b)に125℃における抵抗値(R125)と、間隔aと導電性ポリマの厚みtの比a/tとの関係を示す。第4図(a)、(b)より、a/tが3以上の場合、特に4以上の場合に抵抗値上昇率が大きくなることが確認できた。また、a/tが6以上になると抵抗値上昇率の変化はなくなり、初期(25℃)の抵抗値が高くなることも確認できた。

本発明の目的とするところは、大電流での使用に適したPTCサーミスタを提 25 供することであるから、初期抵抗が高くなることは好ましくない。このため、本 発明に適した a / t の範囲は 3 以上 6 以下が好ましいことが分かった。特に、 a / t の範囲が 4 以上 6 以下がより好ましい範囲といえる。

次に、外層電極12a、12bが導電性ポリマ11の内部に位置する構造となるように、本実施例1に記載した製造方法で作製したシート23の両側にシート

状の導電性ポリマ21を積層して、加熱加圧成形し、その後、以下本実施例1に記載した製造方法と同様にしてチップ形PTCサーミスタを作製した。第5図にPTCサーミスタの断面図を示す。第5図において、導電性ポリマ11の厚みtを0.15mmに固定して、間隔aが0.15mm~1.2mmまで0.15m m間隔で変化するように電解鋼箔のパターン形成を行ってそれぞれのサンプルを作製し、それぞれ5個のサンプルについて前述と同様の方法で、25℃と125℃における抵抗値を測定し、抵抗値上昇率を求めた。その結果は、前述の場合と同様にa/tが3以上の場合、特に4以上の場合には抵抗値上昇率が大きくなることが確認できた。また、a/tが6以上になると抵抗値上昇率の変化はなくなり、初期(25℃)の抵抗値が高くなることも確認できた。

次に、外層電極12a、12bと側面電極13との接続信頼性および内層電極15と側面電極13bとの接続信頼性を上げるために、第6図(a)、(b)に示すように、第1の外層電極12aの延長上に位置して、外層電極12aと独立して、かつ側面電極13bと接続される第一の副電極16aを設けた。また、外層電極12bの延長上に位置して、外層電極12bと独立し、かつ側面電極13bと接続される第2の副電極16bを設けた。さらに、内層電極15の延長上に位置して、内層電極15と独立し、かつ第1の側面電極13aと接続される内層副電極17を設けたチップ形PTCサーミスタを作製した。ここで、「独立」とは、直接電気的に接続していないという意味であり、導電ポリマを介して電気的に接

ここで、導電性ポリマ11の厚み t を 0. 15 mmに固定し、副電極 16 a と 外層電極 12 a 間の間隔、副電極 16 b と外層電極 12 b 間の間隔および内層副電極 17 と内層電極 15 間の間隔をそれぞれ 0. 3 mm以上となるようにして、 第1の側面電極 13 a と内層電極 15 間の間隔 a が 0. 45 mm ~ 1. 2 mm ま で 0. 15 mm間隔で変化するように電解銅箔のパターン形成を行ってそれぞれ のサンプルを作製した。それぞれ 5 個のサンプルについて、前述と同様の方法で、 25℃と 150℃における抵抗値を測定し、抵抗値上昇率を求めた。その結果は、 前述の場合と同様に a / t が 3 以上の場合、特に 4 以上の場合に抵抗値上昇率が 大きくなることが確認できた。また、 a / t が 6 以上になると抵抗値上昇率の変

15

20

25

30

35

40

45

50

化はなくなり、初期 (25℃) の抵抗値が高くなることも確認できた。

なお、本実施例1においては、外層電極12aと外層電極12bとを電気的に接続する第1の電極、第1の外層電極と直接対向する内層電極と電気的に接続する第2の電極として、それぞれ側面電極13aおよび側面電極13bを形成した場合について説明したが、第1の電極および第2の電極を設ける位置は導電性ポリマ11の側面に限定されるものではない。第7図に示すように、第1の電極および第2の電極として、第1の内部貫通電極18aおよび第2の内部貫通電極18bを形成してもよいものである。

すなわち、第7図において、導電性ポリマ11、外層電極12a、外層電極1 2b、保護コート14a、保護コート14b、内層電極15は上記本実施例1と 同様の構成としている。上記実施例(第1図)と異なる点は、外層電極12aと 外層電極12bとを電気的に接続する第1の内部貫通電極18aと、外層電極1 2aと直接対向する内層電極15と電気的に接続される第2の内部貫通電極18 bを形成している点である。このような構成のチップ形PTCサーミスタにおい ても、上記本発明の効果が得られるものである。

また、上記説明においては、側面電極13aおよび側面電極13bを導電性ポリマ11の側面全面および外層電極12aと外層電極12bの端縁部または導電性ポリマ11の第1面、第2面に回り込むように設けた場合について説明したが、側面電極13aおよび側面電極13bを導電性ポリマ11の側面の一部に設けた場合においても、上記本発明の効果が得られるものである。

また上記本実施例1においては、外層電極12a、外層電極12b、内層電極 15を金属箔で形成した場合について説明したが、上記電極は導電性材料をスパッタリング、溶射、めっきによって形成してもよい。また、上記電極は導電材料 をスパッタリングまたは溶射した後に、めっきすることにより形成してもよい。

25 あるいは、上記電極は導電性シートで構成してもよい。導電性シートとしては金 属粉、金属酸化物、導電性を有する窒化物若しくは炭化物、カーボンのいずれか を含む導電性シートが使用できる。さらに上記電極は、金属網と金属粉、金属酸 化物、導電性を有する窒化物若しくは炭化物、カーボンのいずれかを含む導電性 シートで形成しても、同様の効果が得られる。

10

(実施例2)

10

以下、本発明の実施例2におけるチップ形PTCサーミスタについて図而を参 照しながら説明する。第8図は本発明の実施例2におけるチップ形PTCサーミ 5 スタの断面図である。

15

20

25

30

35

40

45

50

第8図において、導電性ポリマ31は高密度ポリエチレンとカーボンプラック 等との混合物からなるPTC特性を有するものである。第1の外層電極32aは 前記導電性ポリマ31の第1面に位置する。第2の外層電極32bは前記導電性 ポリマ31の第2面に位置する。上記電極はそれぞれ銅あるいはニッケル等の金 リマ31の一方の側面全面および前記外層電極32aの端縁部と前記導電性ポリ マ31の第2面とに回り込むように設けられ、かつ前記第1の外層電極32aと 電気的に接続されている。ニッケルめっき層からなる第2の側面電極33bは前 記側面電極33aに対向する前記導電性ポリマ31の他方の側面全面および前記 15 導電性ポリマ31の第1而と前記第2の外層電極32bの端縁部とに回り込むよ うに設けられ、かつ前記第2の外層電極32bと電気的に接続されている。第1、 第2の保護コート34a、34bは前記導電性ポリマ31の第1面と第2面の最 外層に設けられ、エポキシ変性アクリル系樹脂からなる。第1、第2の内層電極 35a、35bは前記導電性ポリマ31の内部に位置して前記外層電極32aと 前記外層電極32bに平行に設けられている。内層電極35aは前記側面電極3 3 b と電気的に接続され、かつ内層電極35 b は前記側面電極33 a と電気的に 接続されている。そしてこれら内層電極は銅あるいはニッケル等の金属箔からな るものである。

以上のように構成された本発明の実施例2におけるチップ形PTCサーミスタ 25 について、次にその製造方法を図面を参照しながら説明する。

第9図(a)~(c)および第10図(a)~(b)は本発明の実施例2にお けるチップ形PTCサーミスタの製造方法を示す工程図である。実施例1と同様 に第9図 (a) に示すシート状の導電性ポリマ41を作製し、次いで、約80 μ mの電解銅箔に金型プレスによりパターン形成を行い、第9図(b)に示す電極

15

20

25

30

35

40

45

55

50

42を作製した。次に第9図(c)に示すようにシート状の導電性ポリマ41の 両側に電極42を重ね加熱加圧成形して一体化した第10図(a)に示す第1の シート43を作製した。次に、第10図(b)に示すように、第1のシート43 の両側から2枚のシート状の導電性ポリマ41と2枚の電極42を電極42が最 5 外層にくるように交互に積層し、加熱加圧成形して一体化した第10図(c)に 示す第2のシート44を作製した。以下本発明の実施例1と同様に製造を行い、

11

本実施例2に記載した製造方法で、導電性ポリマ31の厚み t を 0. 15 mm に固定して、第1、第2の内層電極35a、35bと第1の側面電極33a また は第2の側面電極33b 間の間隔a が 0. 15 mm ~ 1. 2 mm まで 0. 15 m m間隔で変化するように電解銅箔のパターン形成を行ってそれぞれのサンプルを作製した。

木実施例2におけるチップ形PTCサーミスタを作製した。

間隔 a を変化させたことによる抵抗値上昇率の違いを確認するために以下の試験を行った。

15 間隔aが0.15mm~1.2mmまで0.15mm間隔で変化するように形成したサンプルをそれぞれ5個ずつプリント基板に実装し、実施例1と同様に抵抗/温度特性を測定した。その結果は、実施例1と同様に、a/tが3以上の場合、特に4以上の場合に抵抗値上昇率が大きくなることが確認できた。また、a/tが6以上になると抵抗値上昇率の変化はなくなり、初期(25℃)の抵抗値20 が高くなることも確認できた。

次に、外層電極32a、32bが導電性ポリマ31の内部に位置する構造となるように、上記シート44の両側にシート状の導電性ポリマ41を積層し、加熱加圧成形して、以下本実施例2に記載した製造方法と同様にしてチップ形PTCサーミスタを作製した。第11図に作製したPTCサーミスタの断面図を示す。

25 第11図において、導電性ポリマ31の厚み t を 0. 15 mmに固定して、間隔 a が 0. 15 mm~1. 2 mmまで 0. 15 mm間隔で変化するように電解銅箔のパターン形成を行ってそれぞれのサンプルを作製し、それぞれ 5 個のサンプルについて前述と同様の方法で、25 \mathbb{C} と 125 \mathbb{C} における抵抗値を測定し、抵抗値上昇率を求めた。その結果は、前述の場合と同様に a / t が 3 以上の場合、特

層副電極37bを設けた。

認できた。

5

に4以上の場合に抵抗値上昇率が大きくなることが確認できた。また、a/tが 6以上になると抵抗値上昇率の変化はなくなり、初期 (25 $^{\circ}$) の抵抗値が高くなることも確認できた。

10

15

次に、外層電極32a、内層電極35bと第1の側面電極33aとの接続信頼5 性および外層電極32b、内層電極35aと側面電極33bとの接続信頼性を上げるために、下記構造のチップ形PTCサーミスタを作製した。すなわち、第12図(a)、(b)に示すように、外層電極32aの延長上に位置して、外層電極32aと独立し、かつ側面電極33bと接続される第1の副電極36aを設けた。また、外層電極32bと独立し、かつ側面電極33aと接続される第2の副電極36bを設けた。さらに前記内層電極35aの延長上に位置して、内層電極35aと接続される第1の内層副電極37aを設けた。さらにまた、内層電極35bの延長上に

位置して、内層電極35bと独立し、かつ側面電極33bと接続される第2の内

20

25

30

35

40

45

50

上記構造において、導電性ポリマ31の厚み tを0.15mmに固定して、副電極36aと外層電極32a間の間隔、副電極36bと外層電極32b間の間隔、内層副電極37bと内層電極35b間の間隔をそれぞれ0.3mm以上となるようにした。さらに、内層電極35a、35bと側面電極33a若しくは側面電極33b間の間隔aが0.45mm20~1.2mmまで0.15mm間隔で変化するように電解鋼箔のパターン形成を行ってそれぞれのサンプルを作製し、それぞれ5個のサンプルについて、前述と同様の方法で、25℃と125℃における抵抗値を測定し、抵抗値上昇率を求めた。その結果は、前述の場合と同様に、a/tが3以上の場合、特に4以上の場合に抵抗値上昇率が大きくなることが確認できた。また、a/tが6以上になると抵抗値上昇率の変化はなくなり、初期(25℃)の抵抗値が高くなることも確

なお、上記本実施例2においては、第1の電極、第2の電極として、側面電極 33aおよび側面電極33bを形成した場合について述べたが、第1の電極およ び第2の電極を設ける位置は導電性ポリマ31の側面に限定されるものではなく、

10

15

20

25

30

35

40

45

50

13

第13図に示すように、第1の内部負通電極38aおよび第2の内部負通電極3 8bを形成してもよいものである。

すなわち、第13図において、導電性ポリマ31、外層電極32a、外層電極32b、保護コート34a、保護コート34b、内層電極35a、内層電極35bは上記実施例と同様の構成としているもので、異なる点は、外層電極32aと電気的に接続する第1の内部貫通電極38aと、外層電極32bと電気的に接続する第2の内部貫通電極38bを形成している点である。このような構成のチップ形PTCサーミスタにおいても、上記の実施例と同様の効果が得られるものである。

10 さらに、外層電極、側面電極、内層電極の形状、材料なども、実施例1で述べたものと同じものが採用できる。

(実施例3)

第14図において、導電性ポリマ51は高密度ポリエチレンとカーボンブラック等との混合物からなり、PTC特性を有する。第1の外層電極52aは前記導電性ポリマ51の第1面に位置する。第2の外層電極52bは前記導電性ポリマ51の第2面に位置する。これら電極はそれぞれ銅あるいはニッケル等の金属箔からなる。ニッケルめっき層からなる第1の側面電極53aは前記導電性ポリマ51の一方の側面全面および前記外層電極52aの端縁部とに周り込むように設けられ、かつ外層電極52aと外層電極52bとを電気的に接続する。ニッケルめっき層からなる第2の側面電極53bは導電性ポリマ51の他方の側面全面および導電性ポリマ51の第1面と第2面とに回り込むように設けられている。第1、第2の保護コート54a、54bは導電性ポリマ51の第1面と第2面の最外層に設けられ、エポキシ変性アクリル系樹脂からなる。第1、第2、第3の内層電極55a、55b、55cは前記導電性ポリマ51の内部に位置し、外層電極55aと外層電極52bに平行に設けられている。

10

15

20

25

30

35

40

45

50

14

る。内層電極55a、55cは側面電極53bと電気的に接続され、内層電極55bは側面電極53aと電気的に接続されている。これら内層電極は銅あるいはニッケル等の金属箔からなるものである。

以上のように構成されたPTCサーミスタの製造方法について図面を参照しな がら説明する。

第15図(a)~(c) および第16図(a)~(b) は本発明の実施例3におけるPTCサーミスタの製造方法を示す工程図である。上記した実施例1と同様に第15図(a) に示すシート状の導電性ポリマ61を作製し、約80μmの電解銅箔に金型プレスによりパターン形成を行い、第15図(b) に示す電極62を作製した。ここで導電性ポリマ61は完成時には導電性ポリマ51を、電極62は完成時には第1の外層電極52a、第2の外層電極52b、第1~第3の内層電極55a~55cを形成するものである。次に第15図(c) に示すように、2枚のシート状の導電性ポリマ61と3枚の電極62が最外層にくるように交互に重ね、加熱加圧成形して一体化した第16図(a) に示すシート63を作りに、第16図(b) に示すようにシート63の両側から2枚のシート状の導電性ポリマ61と2枚の電極62が最外層にくるように交互に積層し、加熱加圧成形して一体化した第16図(c) に示すシート64を作製した。以下実施例1と同様に製造を行い、本実施例3におけるチップ形PTCサーミスタを作製した。

20 次に、本発明の実施例 3 においてチップ形PTCサーミスタの十分な抵抗値上昇率を得るために、第 1、第 2、第 3 の内層電極 5 5 a 、5 5 b 、5 5 c と側面電極 5 3 a または側面電極 5 3 b 間の間隔 a と、導電性ポリマ 5 1 の厚み t との比 a / t を規定することの必要性について説明する。

本実施例3に記載した製造方法で、導電性ポリマの厚み t を 0. 15 mmに固 25 定して、間隔 a が 0. 15 mm~1. 2 mmまで 0. 15 mm間隔で変化するように電解銅箔のパターン形成を行ってそれぞれのサンプルを作製した。

上記間隔aを変化させたことによる抵抗値上昇率の違いを確認するために以下の試験を行った。

試験は前述した間隔 a が 0. 1 5 m m ~ 1. 2 m m まで 0. 1 5 m m 間隔で変

20

25

30

35

20

40

45

50

化するように形成したサンプルをそれぞれ5個ずつプリント基板に実装し、実施 例1と同様に抵抗/温度特性を測定した。その結果は、本発明の実施例1と同様 に、a/tが3以上の場合、特に4以上の場合に抵抗値上昇率が大きくなること が確認できた。また、a/tが6以上になると抵抗値上昇率の変化はなくなり、 5 初期(25℃)の抵抗値が高くなることも確認できた。

15

次に、外層電極52a、52bが導電性ポリマ5]の内部に位置する構造とな るように、シート64の両側にシート状の導電性ポリマ61を積層し、加熱加圧 成形して、以下本実施例3に記載した製造方法と同様にしてチップ形PTCサー ミスタを作製した。第17図に作成したPTCサーミスタの断面図を示す。導電 10 性ポリマ51の厚み t を 0.15 mmに固定して、間隔 a が 0.15 mm ~ 1. 2mmまで0.15mm間隔で変化するように電解銅箔のパターン形成を行って それぞれのサンプルを作製し、それぞれ5個のサンプルについて、前述と同様の 方法で、25℃と125℃における抵抗値を測定し、抵抗値上昇率を求めた。そ の結果は、前述の場合と同様に a / t が 3 以上の場合、特に 4 以上の場合に抵抗 15 値上昇率が大きくなることが確認できた。また、a/tが6以上になると抵抗値 上昇率の変化はなくなり、初期 (25℃) の抵抗値が高くなることも確認できた。 次に、第1の外層電極52a、第2の外層電極52b、第2の内層電極55b と第1の側面電極53aとの接続信頼性および第1、第3の内層電極55a、5 5cと第2の側面電極53bとの接続信頼性を上げるために、第18図 (a)、 (b) に示す構造のPTCサーミスタを作製した。すなわち、外層電極52aの

延長上に位置して、外層電極52aと独立し、かつ側面電極53bと接続される 第1の副電極56aを設ける。また、外層電極52bの延長上に位置して、外層 電極52bと独立し、かつ第2の側面電極53bと接続される第2の副電極56 bを設ける。さらに内層電極55aの延長上に位置して、内層電極55aと独立 25 し、かつ側面電極53aと接続される第1の内層副電極57aを設ける。さらに また、内層電極55bの延長上に位置して、内層電極55bと独立し、かつ側面 電極53bと接続される第2の内層副電極57bを設ける。そしてまた内層電極 55aの延長上に位置して、内層電極55cと独立し、かつ側面電極53aと接 続される第3の内層副電極57cを設けた。

16

10

15

20

25

30

35

40

45

上記構造において、導電性ポリマ 5 1 の厚み t を 0. 1 5 mmに固定し、副電極 5 6 a と外層電極 5 2 a 間の間隔、副電極 5 6 b と外層電極 5 2 b 間の間隔、内層副電極 5 7 b と内層電極 5 5 b 間の間隔によび内層副電極 5 7 c と内層電極 5 5 c 間の間隔をそれぞれ 0. 3 5 mm以上となるようにして、第 1、第 2、第 3 の内層電極 5 5 a、5 5 b、5 5 c と側面電極 5 3 a または側面電極 5 3 b 間の間隔 a が 0. 4 5 mm ~ 1. 2 m mまで 0. 1 5 mm間隔で変化するように電解銅箔のパターン形成を行ってそれぞれのサンブルを作製し、それぞれ 5 個のサンブルについて、前述と同様の方法で、25℃と 1 25℃における抵抗値を測定し、抵抗値上昇率を求めた。その結 10 果は、前述の場合と同様に、a / t が 3 以上の場合、特に 4 以上の場合に抵抗値上昇率が大きくなることが確認できた。また、a / t が 6 以上になると抵抗値上昇率の変化はなくなり、初期(25℃)の抵抗値が高くなることも確認できた。

なお、本実施例3においては、外層電極52aと外層電極52bとを電気的に接続する第1の電極、第2の電極として説明したが、第1の電極および第2の電極を設ける位置は導電性ポリマ51の側面に限定されるものではなく、第1第9 図に示すように、第1の電極および第2の電極として、第1の内部質通電極58 aおよび第2の内部質通電極58bを形成してもよいものである。

すなわち、第19図において、導電性ポリマ51、外層電極52a、外層電極52b、保護コート54a、54b、内層電極55a、内層電極55b、内層電20 極55cは本実施例3と同様の構成としているもので、本実施例3(第14図)と異なる点は、外層電極52a、52bとを電気的に接続する第1の内部貫通電極58aと、外層電極52aと直接対向する内層電極と電気的に接続する第2の内部貫通電極58bを形成している点である。このような構成のチップ形PTCサーミスタにおいても、上記本実施例3と同様の効果が得られるものである。

25 さらに、外層電極、側面電極、内層電極の形状、材料なども、実施例1で述べたものと同じものが採用できる。

なお、上記実施例の説明においては、結晶性ポリマとして高密度ポリエチレン について説明したが、上記の作用機構から容易に分かるように、本発明はポリフ

WO 00/24010

PCT/JP99/05706

ッ化ビニリデン、PBT樹脂、PET樹脂、ポリアミド樹脂、PPS樹脂等の結晶性ポリマを利用したPTCサーミスタ全でに対応できるものである。

産業上の利用可能性

5 以上のように本発明のPTCサーミスタは、PTC特性を有する導電性ポリマを使用し、第1の電極または第2の電極と内層電極との間隔aと、内層電極間または第1、第2の外層電極と内層電極間の間隔tとの比a/tを3~6の範囲にしたものである。本発明の構成により、PTCサーミスタの抵抗値を低く抑えることができるため、大電流用途に対応できる。かつ、十分な抵抗値上昇率が得ら

10 れるため、本発明のPTCサーミスタは大電流回路の過電流防止にに有効に使用できるものである。

Claims

18

請求の範囲

10

15

1. PTC特性を有する導電性ポリマと、

前記導電性ポリマに接触して設けられた第1の外層電極と、

5 前記導電性ポリマを介し前記第1の外層電極に対向して設けられた第2の外層電極と、

前記第1の外層電極および前記第2の外層電極とに対向すると共にこれらの間に 位置しかつ前記導電性ポリマに挟まれた1以上の内層電極と、

前記第1の外層電極と直接電気的に接続する第1の電極と、

20

25

30

35

40

45

50

10 前記第1の電極と電気的に独立して設けられた第2の電極とを有し、 前記1以上の内層電極のうち前記第1の外層電極に最も近い位置に設けられた内 層電極を1番目とし、順番に数えてn番目に位置する内層電極をn番目の内層電 極としたとき、

奇数番目の内層電極は前記第2の電極に直接接続し、

15 偶数番目の内層電極は前記第1の電極に直接接続し、

前記内層電極が全部で奇数個の場合には前記第2の外層電極と前記第1の電極が 直接電気的に接続し、前記内層電極が全部で偶数個の場合には前記第2の外層電 極と前記第2の電極が直接電気的に接続する構成であり、

前記奇数番目の内層電極から前記第1の電極までの間隔または前記偶数番目の内

20 層電極から前記第2の電極までの間隔をaとし、

前記内層電極のうち隣り合う内層電極の間隔または前記第1の外層電極若しくは 前記第2の外層電極と隣り合う内層電極から前記第1の外層電極若しくは前記第 2の外層電極までの間隔をtとしたとき、

a/tが3~6であることを特徴とするチップ形PTCサーミスタ。

25

2. 請求の範囲第1項の記載において、前記第1の電極は前記導電性ポリマの一方の側面に設けた第1の側面電極であり、前記第2の電極は前記導電性ポリマの他方の側面に設けた第2の側面電極であることを特徴とするチップ形PTCサーミスタ。

3. 請求の範囲第1項の記載において、前記第1の電極は前記導電性ポリマの一 方の内部に設けられた第1の内部貫通電極であり、前記第2の電極は前記導電性 ポリマの内部に設けられた第2の内部貫通電極であることを特徴とするチップ形 5 PTCサーミスタ。

15

4. 請求の範囲第1項の記載において、前記第1の電極は前記導電性ポリマの一 方の側面に設けられ前記第1の外層電極および前記偶数番目の内層電極と直接電 気的に接続された第1の側面電極であり、前記第2の電極は前記導電性ポリマの 他方の側面に設けられ前記奇数番目の内層電極と直接電気的に接続された第2の 側面電極であり、前記内層電極が全部で奇数個の場合には前記第2の外層電極と 前記第1の側面電極が直接電気的に接続し、前記内層電極が全部で偶数個の場合 には前記第2の外層電極と前記第2の側面電極が直接電気的に接続する構成であ ることを特徴とするチップ形PTCサーミスタ。

25

20

15

20

5. 請求の範囲第1項の記載において、前記a/tが4~6であることを特徴と するチップ形PTCサーミスタ。

30

6. PTC特性を有する導電性ポリマと、

35

前記導電性ポリマに接触して設けられた第1の外層電極と、 前記導電性ポリマを介し前記第1の外層電極に対向して設けられた第2の外層電 極と、

40

前記第1の外層電極および前記第2の外層電極とに対向すると共にこれらの間に 位置しかつ前記導電性ポリマに挟まれた1以上の内層電極と、

45

前記第1の外層電極と同じ面上に位置し、前記第1の外層電極とは所定の隙間を 25 隔てて前記導電性ポリマに接触して設けられた第1の外層副電極と、

前記第2の外層電極と同じ面上に位置し、前記第2の外層電極とは所定の隙間を 隔てて前記導電性ポリマに接触して設けられた第2の外層副電極と、

50

前記内層電極と同じ面上に位置し、前記内層電極とは所定の隙間を隔てて前記導

15

20

25

30

35

40

45

20

電性ポリマに挟まれた、前記内層電極と同じ層数の内層副電極と、

前記第1の外層電極と直接電気的に接続する第1の電極と、

前記第1の電極と電気的に独立して設けられ、前記第1の外層副電極に直接電気 的に接続された第2の電極とを有し、

5 前記1以上の内層電極のうち前記第1の外層電極に最も近い位置に設けられた内層電極を1番目とし、順番に数えてn番目に位置する内層電極をn番目の内層電極としたとき、

奇数番目の内層電極および偶数番目の内層副電極は前記第2の電極に直接接続し、 偶数番目の内層電極および奇数番目の内層副電極は前記第1の電極に直接接続し、

- 10 前記内層電極が全部で奇数個の場合には前記第2の外層電極と前記第1の電極が 直接電気的に接続し、かつ前記第2の外層副電極と第2の電極が直接電気的に接 続し、前記内層電極が全部で偶数個の場合には前記第2の外層電極と前記第2の 電極が直接電気的に接続し、かつ前記第2の外層副電極と第1の電極が直接電気 的に接続する構成であり、
- 15 前記奇数番目の内層電極から前記第1の電極までの間隔または前記偶数番目の内 層電極から前記第2の電極までの間隔をaとし、

前記内層電極のうち隣り合う内層電極の間隔または前記第1の外層電極若しくは 前記第2の外層電極と隣り合う内層電極から前記第1の外層電極若しくは前記第 2の外層電極までの間隔をtとしたとき、

- 20 a/tが3~6であることを特徴とするチップ形PTCサーミスタ。
- 7. 請求の範囲第6項の記載において、前記第1の電極は前記導電性ポリマの一方の側面に設けた第1の側面電極であり、前記第2の電極は前記導電性ポリマの他方の側面に設けた第2の側面電極であることを特徴とするチップ形PTCサー 25 ミスタ。

8. 請求の範囲第6項の記載において、前記第1の電極は前記導電性ポリマの一 方の内部に設けられた第1の内部貫通電極であり、前記第2の電極は前記導電性 ポリマの内部に設けられた第2の内部貫通電極であることを特徴とするチップ形

55

21

PTCサーミスタ。

10

15

9. 請求の範囲第6項の記載において、前記第1の電極は前記導電性ポリマの… 方の側面に設けられ前記第1の外層電極、前記偶数番目の内層電極および前記奇 5 数番目の内層副電極と直接電気的に接続された第1の側面電極であり、前記第2 の電極は前記導電性ポリマの他方の側面に設けられ前記第1の外層副電極、前記 奇数番目の内層電極および前記偶数番目の内層副電極と直接電気的に接続された 第2の側面電極であり、前記内層電極が全部で奇数個の場合には前記第2の外層 電極と前記第1の側面電極が直接電気的に接続し、かつ、前記第2の外層副電極 10 と第2の側面電極が直接電気的に接続し、前記内層電極が全部で偶数個の場合に は前記第2の外層電極と前記第2の側面電極が直接電気的に接続し、かつ前記第 2 の外層副電極と第1の側面電極が直接電気的に接続する構成であることを特徴

20

25 とするチップ形PTCサーミスタ。

15 10. 請求の範囲第6項の記載において、前記 a / t が 4 ~ 6 であることを特徴 とするチップ形PTCサーミスタ。

35

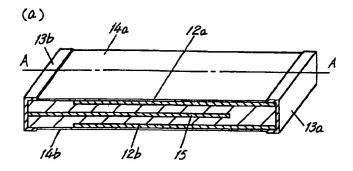
30

40

45

50

FIG. 1



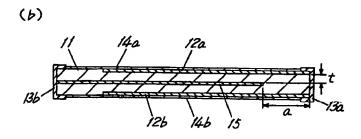
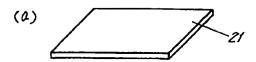
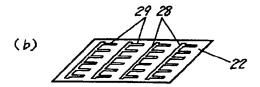


FIG. 2





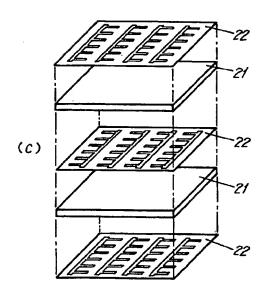
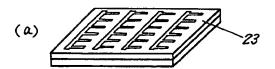
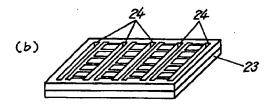
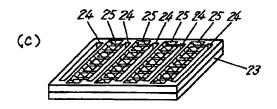
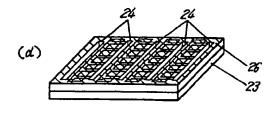


FIG. 3









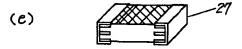
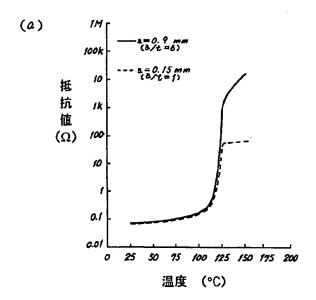


FIG. 4



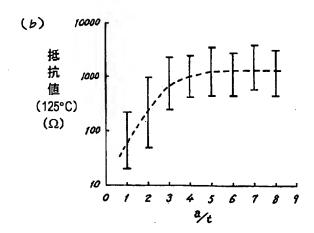


FIG. 5

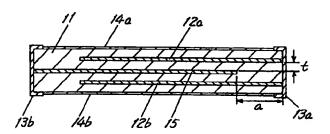
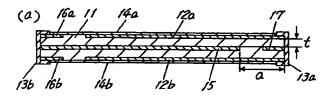


FIG. 6



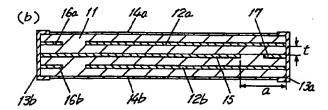
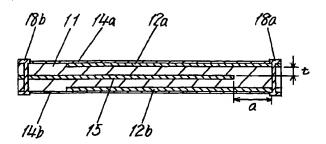


FIG. 7



WO 00/24010

PCT/JP99/05706

FIG. 8

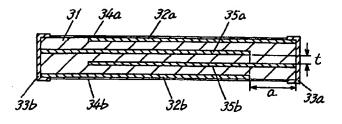
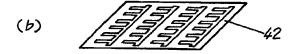


FIG. 9





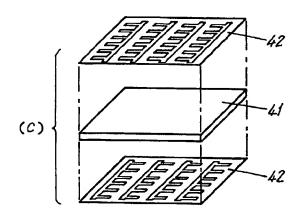
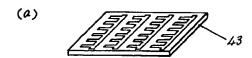
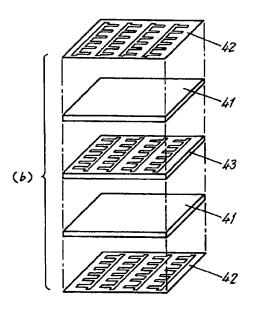


FIG. 10





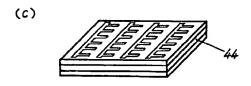


FIG. 11

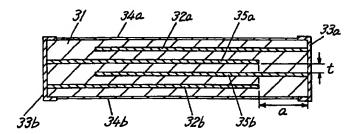
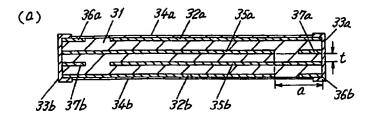


FIG. 12



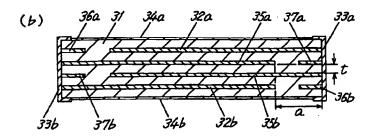


FIG. 13

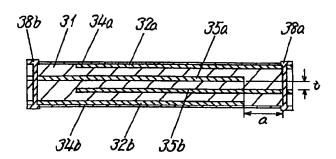


FIG. 14

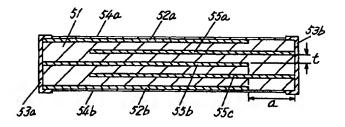
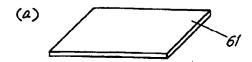


FIG. 15





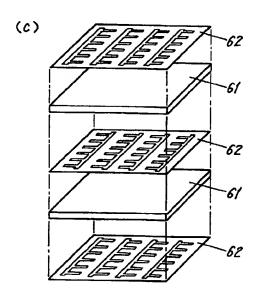
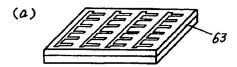
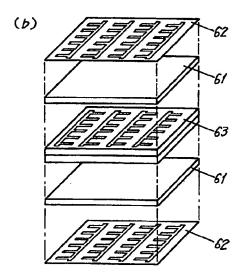
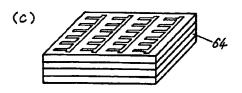


FIG. 16







WO 00/24010

PCT/JP99/05706

FIG. 17

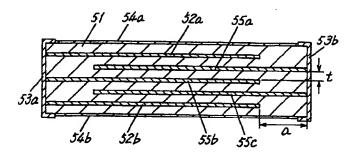
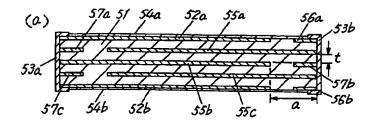


FIG. 18



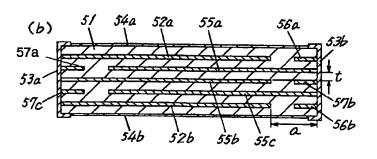
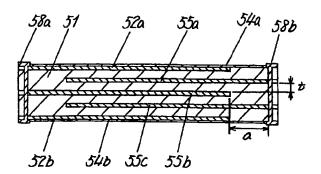


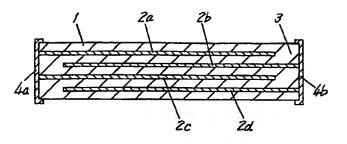
FIG. 19



WO 00/24010

PCT/JP99/05706

FIG. 20



図面の参照符号の一覧表

1 1, 3 1, 5 1 導電性ポリマ 1 2 a, 3 2 a, 5 2 a 第 1 の外層電極 1 2 b, 3 2 b, 5 2 b 第 2 の外層電極 1 3 a, 3 3 a, 5 3 a 第 1 の側面電極 1 3 b, 3 3 b, 5 3 b 第 2 の側面電極 1 5 内層電極 3 5 a, 5 5 a 第 1 の内層電極 3 5 b, 5 5 b 第 2 の内層電極 5 5 c 第 3 の内層電極

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05706

		1,0133,03.00		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01C7/02				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl? H01C7/02				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999				
Electronic data base consulted during the international search (name	of data base and, where practica	ible, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category* Citation of document, with indication, where app				
X JP, 10-12404, A (Matsushita Ele A 16 January, 1998 (16.01.98) (E	ctric Ind. Co., Ltd Family: none)	1.), 1,2,4,5 3,6-10		
A JP, 4-346409, A (ROHM CO., LTD. 02 December, 1992 (02.12.92)), (Family: none)	1-10		
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" cartier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search	priority date and not in confl understand the principle or t document of particular relev considered novel or cannot t step when the document is to document of particular relev considered to involvo an inv combined with one or more combination being obvious t "&" document member of the san	r document published after the international filing date or writy date and not in conflict with the application but cited to tersand the principle or theory underlying the invention unsent of particular relevance; the claimed invention cannot be sidered novel or cannot be considered to involve an inventive when the document is taken alone unsent of particular relevance; the claimed invention cannot be sidered to involve an inventive step when the document is abined with one or more other such documents, such abination being obvious to a person skilled in the art unnent member of the same patent family mailing of the international search report		
11 January, 2000 (11.01.00) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	25 January, 20	00 (25.01.00)		
Facsimile No.	Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP9	9/05706
A. 発明のは Int Cl' HO	(する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 1 C7/02	·	
B. 調査を行 調査を行った。 Int Cl' HO	小限資料(国際特許分類(IPC))		
日本国実用新 日本国公開実 日本国登録実	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 案公報 1926-1996年 用新案公報 1971-1999年 用新案公報 1994-1999年 案登録公報 1996-1999年		
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	関査に使用した用語)	
	3と認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	: きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP. 10-12404, A (松7月, 1998 (16.01.98)	「電器産業株式会社)16 1	1, 2, 4, 5 3, 6-10
A	JP, 4-346409, A (ロー 992 (02. 12. 92) (ファミ	- ム株式会社) 2. 12月. 1 ミリーなし)	1-10
□ C畑の鉢	きにも文献が列帯されている。	「パテントマーンリー1785年75	7119rf. +- de F07
* 引用文献師 「A」特にの出い もの際代に 「E」国以後に 日本以後のでは 「L」を表すし、「 「D」国際 「P」国際	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に官及する文献 質日的で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出版日又は優先日後に公表 「T」国際出版日又は優先日後に公表 て出版と矛盾するものではなく 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	された文献であって 、
国際調査を完	7した日 11.01.00	国際調査報告の発送日 25	.01.00

特許庁審査官 (権限のある職員) 5R 9298 重田 尚郎 1 1 1 01 内線 3565

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区殿が関三丁目4番3号